



| | |
|---|---|
|  | <h2>SI5509DC-T1-E3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI5509DC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5509DC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2538 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI5509DC-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 2538 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206-8 ChipFET™ |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 52 mOhm @ 5A, 4.5V |
| Leistung - max | 4.5W |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, Flat Lead |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 455pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 6.6nC @ 5V |
| Typ FET | N and P-Channel |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.1A, 4.8A |

SI5509DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5509DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5509DC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5509DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI5509DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p> |  <p>SI5504DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p> |  <p>SI5511DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p> |  <p>SI5504DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p> |
|  <p>SI5504DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p> |  <p>SI5509DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p> |  <p>SI5504DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p> |  <p>SI5504DC-T1 VISHAY SI5504DC-T1 VISHAY</p> |

SI5509DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| Schlüsselwort | SI5509DC-T1-E3 | SI5509DC-T1-E3 | SI5509DC-T1-E3 | SI5509DC-T1-E3 |
| SI5509DC-T1-E3 / Siliconix | SI5509DC-T1-E3 Datenblatt | SI5509DC-T1-E3-Datenblätter | SI5509DC-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI5509DC-T1-E3 |
| SI5509DC-T1-E3 Electronic | SI5509DC-T1-E3-Komponenten | SI5509DC-T1-E3-Verteiler | SI5509DC-T1-E3-Bild | SI5509DC-T1-E3-Teil |
| SI5509DC-T1-E3 Preis | SI5509DC-T1-E3 Hersteller | SI5509DC-T1-E3 Bild | SI5509DC-T1-E3 Aktie | SI5509DC-T1-E3 Inventar |
| SI5509DC-T1-E3 Neu | SI5509DC-T1-E3 Original | SI5509DC-T1-E3 garantiert | SI5509DC-T1-E3 RFQ | SI5509DC-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited